

2SB1322, 2SB1322A

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形

低周波電力増幅

2SD1994, 2SD1994A とコンプリメンタリ

■ 特長

- 2SD1994, 2SD1994A とコンプリメンタリペア。
- ラジアルテーピングでの供給可能。

■ 絶対最大定格 (Ta=25°C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V _{CBO}	-30	V
2SB1322		-60	
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	-25	V
2SB1322A		-50	
エミッタ・ベース電圧	V _{EBO}	-5	V
せん頭コレクタ電流	I _{CP}	-1.5	A
コレクタ電流	I _C	-1	A
コレクタ損失	P _C *	1	W
接合部温度	T _j	150	°C
保存温度	T _{stg}	-55~+150	°C

*プリント基板：コレクタ部分の銅箔面積 1 cm²以上厚み1.7mm

■ 電気的特性 (Ta=25°C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I _{CBO}	V _{CB} = -20V, I _E = 0			-0.1	μA
コレクタ・ベース電圧	V _{CBO}	I _C = -10 μA, I _E = 0	-30			V
			-60			
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	I _C = -2 mA, I _B = 0	-25			V
			-50			
エミッタ・ベース電圧	V _{EBO}	I _E = -10 μA, I _C = 0	-5			V
直流電流増幅率	h _{FE1} * ¹	V _{CE} = -10V, I _C = -500mA* ²	85		340	
	h _{FE2}	V _{CE} = -5V, I _C = -1A* ²	50			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = -500mA, I _B = -50mA* ²			-0.4	V
ベース・エミッタ飽和電圧	V _{BE(sat)}	I _C = -500mA, I _B = -50mA* ²			-1.2	V
トランジション周波数	f _T	V _{CB} = -10V, I _E = 50mA, f = 200MHz		200		MHz
コレクタ出力容量	C _{ob}	V _{CB} = -10V, I _E = 0, f = 1 MHz		20	30	pF

*²パルス測定*¹h_{FE1} ランク分類

ランク	Q	R	S
h _{FE1}	85~170	120~240	170~340

